PAT-NO: JP358017640A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 58017640 A

TITLE: SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: February 1, 1983

INVENTOR-INFORMATION:

NAME NAKAGAWA, KOICHI TACHIKAWA, TORU BANJO, TOSHINOBU

to 😘 🍎

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY MITSUBISHI ELECTRIC CORP N/A

APPL-NO: JP56116664

APPL-DATE: July 24, 1981

INT-CL (IPC): H01L023/00, B41M001/30

US-CL-CURRENT: 257/E23.179, 346/141

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To enable to trace a rod history even if a conventional marking is vanished and to automatically process a semiconductor by forming a readable type marking on the surface of the device and forming a <u>bar code</u> type marking at the prescribed positions.

CONSTITUTION: In a drawing, numeral 1 designates an IC, 2 a front surface, while 3 a back surface. The surface 2 is a surface which necessitates identifying by a personnel a marking even after the IC1 is eventually mounted on a printed board. On the surface 2 is printed marking characters 4 in the size of the degree capable of reading by the personnel. On the surface 3 is printed a <u>bar code</u> marking 5 which is not read by the personnel but capable of being identified for the information by converting the optical information into an electric signal. Even if the characters 4 capable of being identified by the personnel on the surface 2 are, for example, vanished, the tracing of the rod history can be performed by the marking 5 of the <u>bar code</u>.

COPYRIGHT: (C) 1983, JPO&Japio

# (19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭58-17640

f) Int. Cl.<sup>3</sup>
H 01 L 23/00
B 41 M 1/30

識別記号

庁内整理番号 6555-5F 7174-2H **3公開** 昭和58年(1983)2月1日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

#### 60半導体装置

②特 願 昭56-116664

**20**出 願 昭56(1981) 7 月24日

70発 明 者 中川興一

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電 機株式会社北伊丹製作所內

@発 明 者 立川透

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電

機株式会社北伊丹製作所内

仰発 明 者 番條敏信

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電機株式会社北伊丹製作所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

@代理人 弁理士 葛野信一 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

半導体装置

### 2. 特許請求の範囲

- (i) 半導体業子を樹脂對止してなる半導体装置 において、前配半導体装置の表面に判読可能な活 字型のマーキングを有し、さらに前配半導体装置 の所要個所に光学的情報を電気的信号に変換する ことにより判読できるパーコード型式のマーキン グを散けたことを特徴とする半導体装置。
- (2) バーコード型式のマーキングは、半導体装置の裏面に設けられたことを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載の半導体装置。
- (3) 判胱可能なマーキングは、マーキング用例 脂を印刷して形成され、パーコード型式のマーキ ングは、レーザによる樹脂表面への撮り込みであ ることを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載の 半導体装置。
- 3. 発明の詳細な説明

この発明は、樹脂封止型半導体装置、特に半導

体集積回路のマーキング方法の改良に関するもの である。

第1図に树脂封止型半導体無機回路(以下1 C と略す)の一例を示す。樹脂對止されてしまうと 樹脂内部にパッケーシングされている I C の種類 が不明になつてしまうので、通常、I C の樹脂 面には製品の種類、製造ロット番号等がマーキン グされる。

このマーキングは通常、マーキング用インクで 印刷するなどの方法により実施されるが、これに は以下のような欠点がある。

第1で、マーキング用インクで印刷された場合は、マーキング後の電気テスト、敷終実装等の工程を軽ると、マーキング文字が消えたり、鋭みにくくなつたりすること。

第2に、人間が判脱できる程度の大きさでIC 表面にマーキングを施す場合はICの表面機が小さいので、マーキングの中に盛り込むことのできる情報量が少なく、不良の生じた場合の製造履歴などの調査に不充分であること。 この発明は、上配の従来の欠点を解消するため ICにパーコード型式のマーキングを実施したも のである。以下、この発明について説明する。

第1図、第2図はこの発明の一実施例を示すもので、1はIC、2は表面、3は裏面であり、表面2はIC1を敏終的にブリント基板などに実装した後にも人間がマーキングの判既を必要とする面である。この表面2には、人間の判例できる程度の大きさでマーキング文字4を印刷する。

また第2図に示すように裏面3には、人間の利 既は不可能であるが光学的情報を電気信号に変換 することにより情報を判断することが可能なバー コード型式のマーキング5を実施する。

このパーコードの内容は、例えば、

製品の型名

製造ロツト番号

製造工場

製造装置名

製造年月日

などの内容を含んだ情報である。

なお、以上の実施例は、I C 1 の裏面 3 にバーコードをマークする場合について説明したが、この発明はこれに限定されるものではなく、I C 1 の表面 2 や側面等の任意の部分にバーコードをマークしても、上記実施例と同様の作用効果を奏することは明らかである。

以上詳細に説明したように、この発明は半導体装置の表面に判読可能な活字型のマーキングを設け、さらに所要個所にパーコード型式のマーキングを設けたので、従来のマーキングが消えてもロッド履歴の追跡が可能であり、かつ自動的に処理ができる利点がある。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図, 第2図はこの発明の一実施例を示すもので、第1図はICの表面側の斜視図、第2図は 第1図の裏面側の斜視図である。

図中、1はIC、2は表面、3は裏面、4はマーキング文字、5はマーキングである。なお、図中の同一符号は同一または相当部分を示す。

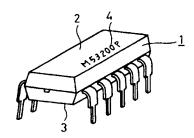
このバーコードのマーキング5によつて、例えば装面2の人間の判抗可能なマーキング文字4が 値えてもロット腱歴の追跡が可能となる。

またリードフレームタイプの樹脂封止型ICの樹脂封止直後にIC1の裏面にバーコード型式のマーキング5を施しておけば、樹脂封止後IC1がリードフレームから1つずつ独立に切り離されたあとの工程を経ても他の製品の混入を防止することができる。またこのバーコードを脱み取ることにより電気的テストのブログラムを自動的に選択することが可能となり、人間を必要としない一貫生産システムへの展開が可能となる。

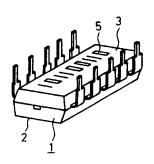
この発明ではIC1の表面に従来型のマーキング も実施するため、従来のICのマーキングの特徴 も扱うことがない。

級面3のパーコードをマークする方法としては、 例えばレーザ光により樹脂袋面に傷をつけておけ は光学的情報として処理をすることが可能である。 このとき、線幅 0.5~1 mm, 線長 1~3 mm 程度に しておけば光学的に被出するには充分である。

#### 第 1 図



#### 第 2 図



以上

明細書の発明の詳細な説明の側および図面

あるのを、「I C 1 の裏面 3 に」と補正する。 (2) 同じく第 4 頁 1 3 行に「I C 1 の表面に」

とあるのを、「1C1の表面2に」と補正する。

(3) 第2凶を別紙のように補正する。

(1) 明細書第4頁5行に「IC1の裏面に」と

特許庁長官殿

1. 事件の表示

特知的 56-116664号

2. 発明の名称

半進体基量

3. 補正をする者

事件との関係 住 所 特許出願人

作 亦 名 称 (601) 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社

代表者 片 山 仁 八 郎

4. 代 理 人 住 所

氏 名(6699)

